

MÓDULO	MATERIA	ASIGNATURA	CURSO	SEMESTRE	CRÉDITOS	CARÁCTER
			1	2	6	Optativo
PROFESOR(ES)			DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.)			
- Francisco J. Gámiz Pérez - Juan Antonio Jiménez Tejada - Juan Bautista Roldán Aranda			Dpto. de Electrónica y Tecnología de Computadores. Facultad de Ciencias 2ª planta Sec. Físicas. FJGP: Despacho nº 8, Correo electrónico: fgamiz, extensión: @ugr.es JAJT: Despacho nº 13, Correo electrónico: tejada, extensión: @ugr.es JBRA: Despacho nº 15, Correo electrónico: jroldan, extensión: @ugr.es			
			HORARIO DE TUTORÍAS			
			https://oficinavirtual.ugr.es/ai/ -> ordenación docente -> tutorías			
MÁSTER EN EL QUE SE IMPARTE			OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR			
Máster en Física						
PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede)						
Se recomienda tener conocimientos básicos en Semiconductores y Electrónica.						
BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER)						
Mecanismos de dispersión de los portadores. Transporte de carga en nanodispositivos electrónicos. Técnicas de simulación numérica y modelado compacto. Método de Monte Carlo. Herramientas y técnicas de caracterización eléctrica. Ruido en nanodispositivos electrónicos.						
COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO						



CG3 - Capacidad de trabajo en equipo. El estudiante deberá integrar su trabajo en el interés de un proyecto común.

CG4 - Capacidad de expresar y defender en público los resultados y conclusiones obtenidos como resultado del proceso de aprendizaje. Deberá desarrollar y dominar las técnicas de comunicación oral ante cualquier auditorio. Aprender a utilizar sus potencialidades personales para presentar resultados públicamente. Adquisición del convencimiento de que su conocimiento del trabajo realizado le convierte de inmediato en foco de interés y atención.

CG5 - Capacidad de generación de propuestas innovadoras y competitivas en la investigación y en la actividad profesional.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT2 - Compromiso ético. Tanto en su etapa de alumno como posteriormente en su trabajo profesional, el estudiante debe ser consciente de la absoluta necesidad de realizar sus tareas con absoluto respeto a la honradez, la verdad y el servicio a la sociedad.

CT1 - Capacidad de razonamiento crítico: el estudiante debe ser capaz de distinguir aquellos aspectos de su trabajo o del de otros que suponen innovación y avance.

CT3 - Capacidad de automotivación. Forma parte de la madurez que debe alcanzarse en el proceso formativo a estos niveles: las dificultades han de enfrentarse con decisión y confianza.

CT4 - Capacidad de reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad. Forma parte de la actitud vital que se supone al graduado: su conciencia social ha de guiar aquellos aspectos de su profesión que involucren a otros miembros de la comunidad.

CE1 - Capacidad de interpretar datos procedentes de la observación experimental o la simulación numérica.

CE2 - Capacidad de considerar rigurosamente las limitaciones e incertidumbres en los resultados y de los métodos que pueden aplicarse para minimizarlas.

CE3 - Capacidad de profundizar en los distintos campos de la Física y de identificar los aspectos que se encuentran en los límites del conocimiento.

CE4 - Capacidad de formular hipótesis, idear experimentos, manejar métodos de cálculo y simulación numérica y desarrollar modelos.

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA)

El alumno sabrá/comprenderá:

- Utilizar las principales herramientas de simulación numérica de los nanodispositivos semiconductores.
- Resolver ecuaciones diferenciales en derivadas parciales (Ecuación de Poisson, Schroedinger, continuidad, transporte de Boltzmann) mediante diferentes técnicas tanto deterministas como estocásticas (método de Monte Carlo), en estructuras semiconductoras reales.
- Enfrentarse a problemas de transporte de carga en diferentes estructuras, y cálculo de estructuras de bandas.
- Desarrollo de modelos compactos de dispositivos electrónicos para la simulación de circuitos.
- Técnicas de implementación de modelos compactos en simuladores de circuitos comerciales.



- Extracción de parámetros en modelos compactos.
- Técnicas numéricas avanzadas para el modelado y la extracción de parámetros.
- Distinguir diferentes tipos de ruido que se localizan en los nanodispositivos electrónicos.
- Medir el ruido en un dispositivo electrónico
- Caracterizar parámetros físicos de un dispositivo semiconductor a partir de medidas de ruido.
- Las herramientas matemáticas básicas para el tratamiento del ruido en los dispositivos electrónicos.
- Distintos tipos de ruido que se origina en los dispositivos semiconductores.
- Técnicas de extracción de parámetros de modelos de dispositivos basadas en medidas de ruido.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

- 1.- Nociones básicas sobre los transistores de efecto campo.
- 2.- Métodos numéricos para la resolución de las ecuaciones de Poisson, Schroedinger y Boltzmann.
- 3.- Mecanismos de dispersión de los portadores: Rugosidad superficial, culombiano, vibraciones de la red, interacción portador-portador.
- 4.- Método de Monte Carlo de una y muchas partículas aplicado al transporte de carga en estructuras semiconductoras.
- 5.- Metodología de desarrollo de modelos compactos de dispositivos electrónicos.
- 6.- Técnicas avanzadas de resolución analítica de ecuaciones diferenciales y aproximación de funciones.
- 7.- Técnicas de extracción de parámetros de modelos de dispositivos electrónicos.
- 8.- Estudio del ruido en dispositivos electrónicos. Herramientas matemáticas.
- 9.- Tipos de ruido y su localización en las diferentes regiones de un dispositivo.
- 10.- Caracterización de un dispositivo electrónico a partir de medidas de ruido.

BIBLIOGRAFÍA

- Lundstrom, M.; "Fundamentals of carrier transport", Modular Series on Solid - State Devices Vol. X, Addison Wesley Publishing Company 1990.
- Taur, Y. and Ning T.H.; "Fundamentals of modern VLSI devices", Cambridge University Press, 1998
- Hess, K.; "Advanced theory of semiconductor devices", Wiley-IEEE Press, 1999
- Selberherr, S. "Analysis and simulation of semiconductor devices", New York: Springer, 1984.
- Hänsch W.; "The drift-diffusion equation and its applications in Mosfet modeling", Springer-Verlag New-York Inc, 1991
- Moglestue. C. "Monte Carlo simulation of semiconductor devices", Chapman&Hall, 1993
- C.Jacoboni and P.Lugli, "The Monte Carlo method for semiconductor device simulation", Springer Verlag, 1989
- R.W.Hockney and J.W.Eastwood, "Computer Simulation using particles", Institute of Physics Publishing, 1988
- K.Tomizawa, "Numerical simulation of submicron semiconductor devices", Artech House, 1993.
- A.A. Baladin, ed. "Noise and fluctuations. Control in electronic devices". American Scientific Publishers. 2002.



-Van der Ziel, "Noise in solid state devices and circuits", New York. Wiley. 1986.
 -Y.P. Tsividis, "Operation and Modeling of the Metal-oxide Semiconductor transistor", McGraw Hill, 1999.
 -C. Galup-Montoro, M.C. Schneider, "MOSFET modeling for circuit analysis and design", World Scientific, 2007.
 -C. Enz and E.A. Vittoz, "Charge-Based MOS Transistor Modeling: The EKV Model for Low-Power and RF IC Design". New York: Wiley, 2006.
 -A.B. Bhattacharyya "Compact MOSFET models for VLSI design", John Wiley and Sons, 2009.

ENLACES RECOMENDADOS

METODOLOGÍA DOCENTE

- Se iniciará el curso con clases introductorias donde se plantearán los objetivos y se informará de los contenidos fundamentales.
- Se propondrán trabajos comunes a todos los estudiantes que deberán presentar de forma oral e individualizada al profesor a medida que lo vayan desarrollando. Además de la bibliografía, el alumno contará con artículos científicos para desarrollar estos trabajos.
- Se realizarán prácticas de laboratorio de medida de ruido en un dispositivo. Se complementa la experiencia con la determinación de algunos parámetros del dispositivo y con la discusión de los resultados e informes realizados.
- La discusión de resultados se realizará también de forma oral, la participación activa de los estudiantes es fundamental en este curso. Los resultados se compararán con otros que aparecen en la literatura con el objeto de que el estudiante desarrolle un juicio crítico.
- Estas actividades formativas tienen el objeto de garantizar que alcancen las competencias generales del máster. De forma particular servirán de ensayo para cuando tengan que enfrentarse a su trabajo de investigación.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

- El mínimo para superar este curso lo constituirán unas entrevistas y/o exámenes sobre los contenidos fundamentales del mismo.
- La obtención de una calificación mayor por parte del estudiante será función de su trabajo personal en las tareas impuestas a lo largo del curso: trabajos comunes y prácticas dirigidas por los profesores.
- La calificación final responde al siguiente baremo: Exámenes (oral/escrito) sobre conocimientos (50%). Prácticas obligatorias junto a memoria de resultados (50%)

INFORMACIÓN ADICIONAL

